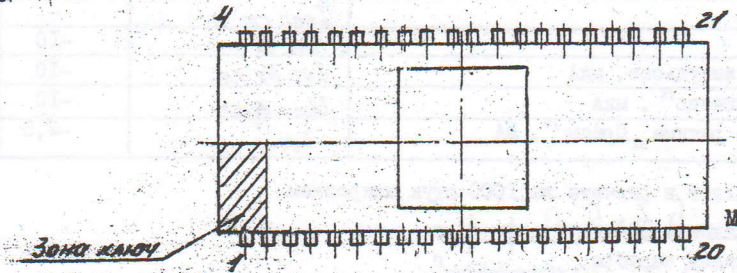
Перепроверен

ЭТИКЕТКА

8 - 1288.

Микросхема 580ВМ80

Полупроводниковая интегральная микросхема 580ВМ80 на n-канальных МОП транзисторах в металлокерамическом корпусе, предназначенная для работы в электронных устройствах в качестве параллельного центрального процессорного устройства. Климатическое исполнение УХЛ.



Масса не более 8 г

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

Номер вывода микросхемы	Обозначение вывода (сигнала)	Тип вывода	Назначение вывода (сигнала)
I	AI0	Вых	Адресные шины микросхемы
2	⊥	–	Корпус
3	Д4	Вх/вых	Шины данных микросхемы (двунаправленные трехстабильные)
4	Д5		
5	Д6		
6	Д7		
7	Д3		
8	Д2		
9	Д1		
I0	Д0		
II	-5 В	–	Напряжение смещения подложки
I2	УСТ	Вх	Установка
I3	ЗШ	Вх	Запрос шин
I4	ЗПР	Вх	Запрос прерывания
I5	ТИ2	Вх	Сигнал тактового импульса
I6	ППР	Вых	Подтверждение прерывания
I7	ПМ	Вых	Прием
I8	$\overline{ВД}$	Вых	Выдача
I9	С	Вх	Синхронизация
20	5 В	–	Напряжение питания
2I	ПЗШ	Вых	Подтверждение запроса шин
22	ТИ	вх	Сигнал тактового импульса
23	ГГ	вх	Готовность
24	ЖД	вых	Ожидание
25	A0	Вых	Адресные шины микросхемы
26	AI		
27	A2		
28	I2 В	–	Напряжение питания
29	A3	Вых	Адресные шины микросхемы
30	A4		
3I	A5		
32	A6		
33	A7		
34	A8		
35	A9		
36	AI5		
37	AI2		
38	AI3		
39	AI4		
40	AII		

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ МИНУС 60 ДО 85 °С

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
I. Выходное напряжение высокого уровня, В	$U^1_{вых}$	3,7	–
2. Выходное напряжение низкого уровня, В	$U^0_{вых}$	–	0,45
3. Ток потребления от $U_{п.1}$, мА	$I_{пот.1}$	–	85
Ч. Ток потребления от $U_{п2}$, мА	$I_{пот.2}$	–	II0
5. Ток потребления от $U_{см.п}$, мА	$I_{пот.см.п}$	–	I,0
6. Ток утечки на входах, мкА	$I_{ут.вх}$	-I0	I0
7. Ток утечки на входах тактовых импульсов, мкА	$I_{ут.вх.тн}$	-I0	I0
8. Выходной ток в состоянии „Выключено", мкА	$I_{вых.выкл}$	-I0	I0
9. Входной ток по каналу данных в режиме „Прием", мА	$I_{вх.А}$	-2,0	–

Содержание драгоценных металлов в расчете на I000 штук микросхем

Содержание золота 0,1 г

Содержание серебра 1,36 г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема 580ВМ80 соответствует техническим условиям бК0.347.281-0I ТУ.

Принята по извещению № 13 от XII.88 г
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

conector.by